PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-145954

(43)Date of publication of application: 22.05.2002

(51)Int.Cl. C08F220/28

CO8K 5/00 CO8L 33/14

G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number : 2000-343762 (71)Applicant : DAIGEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing: 10.11.2000 (72)Inventor: TSUTSUMI KIYOHARU
FUNAKI KATSUNORI

(54) POLYMER COMPOUND FOR PHOTORESIST AND METHOD FOR PRODUCING THE COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer compound for photoresist, containing uniformly distributed monomer units, having small intramolecular and intermolecular compositional distributions and exhibiting excellent etching resistance.

SOLUTION: The polymer compound for photoresist is produced by the copolymerization of a monomer mixture containing three kinds of (meth)acrylic acid esters comprising (A) a compound of formula 1, (B) a compound of formula 2 and/or 3 and (C) a (meth)acrylic acid

(B) a compound of formula 2 and/or 3 and (C) a (meth)acrylic acid seter of formula 4 having a substituted adamantane ring (R2, R12 and R13 are each H or a 1-3C hydrocarbon group; R14 is a 6-20C bridged alicyclic hydrocarbon group; R16 is methyl or the like; R18 and R19 are each H, hydroxy group, oxo group or carboxy group provided that R18 and R19 are not H at the same time; (p), (q), (r) and (s) are each 0 or 1: and p+q+r+s is 2-4).

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CL AIMS

[Claim(s)]

[Claim 1](A) a following formula (1)

[Formula 1]

(R^1 shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula) R^2 shows the hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-3, R^3 , R^3 , R^3 , R^3 , R^3 , R^3 , R^3 , and R^{10} show a hydrogen atom or a methyl group independently, respectively, p, q, r, and s show 0 or 1 independently, respectively, p+q+r+s=2-4 [however,] — it is — the acrylic ester which has a lactone ring of 5 expressed – 7 members (meta–), and the (B) following formula (2)

[Formula 2]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

 $(R^{11}$ shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{12} and R^{13} show the hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-3 independently, respectively. R^{16} shows the owner pons alicyclic hydrocarbon group of the carbon numbers 6-20. t— the integer of 0-5— being shown— the acrylic ester which has an owner pons alicyclic hydrocarbon group with which it is expressed (meta—), and a following formula (3)

[Formula 3]

 $(R^{15}$ shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{16} — a methyl group or an ethyl group — being shown — at least one sort of acrylic ester (meta-) chosen from the acrylic ester which has an adamantane ring expressed (meta-), and the (O) following formula (4)

[Formula 4]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $Q^{1.9}$
 $Q^{1.9}$
 $Q^{1.9}$

 (R^{17}) shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{18} and R^{19} are substituents combined with an adamantane ring, and show a hydrogen atom, hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group independently,

respectively. Either [however, / at least] R^{18} or R^{19} hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group — it is — a high molecular compound for photoresist produced by carrying out copolymerization of the monomeric mixture which contains three sorts of acrylic ester (meta-) of acrylic ester which has an adamantane ring which has a substituent expressed (meta-) at least.

[Claim 2](Meta) The high molecular compound for photoresist according to claim 1 whose value of a solubility parameter by a method of Fedors of acrylic ester (C) is the range of 20.4(J/cm³)^{1/2} – 23.5(J/cm³)^{1/2}.

[Claim 3](Meta) The high molecular compound for photoresist according to claim 1 whose weight average molecular weight rates of a copolymerization ratio of acrylic ester (C) are 1 - 50-mol %, and is 1.000-500.000.

[Claim 4]A high molecular compound for photoresist given in which paragraph of claims 1–3 whose values of a solubility parameter by a method of Fedors are the ranges of $19.4(J/cm^3)^{1/2} - 24.6(J/cm^3)^{1/2}$.

[Claim 5](A) A following formula (1)

Formula 5]

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ CH_{2} = C \\ C = 0 \\ R^{2} \\ (R^{3}R^{4}C)_{p} \\ (R^{5}R^{6}C)_{q} \\ CR^{7}R^{8})_{r} \\ (R^{5}R^{6}C)_{q} \\ CR^{9}R^{10})_{s} \end{array}$$
 (1)

(R' shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^2 shows the hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1–3. R^2 , R^4 , R^5 , R^5 , R^5 , R^5 , R^5 , and R^{10} show a hydrogen atom or a methyl group independently, respectively, p, q, r, and s show 0 or 1 independently, respectively, p+q+r+s=2-4 [however,] — it is — the acrylic ester which has a lactone ring of 5 expressed – 7 members (meta–), and the (B) following formula (2)

[Formula 6]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $(R^{12} - C - R^{13})_t$
 (2)

 (R^{11}) shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{12} and R^{13} show a hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-3 independently, respectively. R^{14} shows an owner pons alicyclic hydrocarbon group of the carbon numbers 6-20. t— an integer of 0-5— being shown — acrylic ester which has an owner pons alicyclic hydrocarbon group with which it is expressed (meta-), and a following formula (3)

[Formula 7]

$$CH_2 = C R^{15}$$

$$C = 0$$

$$R^{16}$$

$$R^{16}$$

 $(R^{15}$ shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{16} — a methyl group or an ethyl group — being shown — at least one sort of acrylic ester (meta—) chosen from the acrylic ester which has an adamantane ring expressed (meta—), and the (C) following formula (4)

[Formula 8]

$$C1_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

 (R^{17}) shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{18} and R^{19} are substituents combined with the adamantane ring, and show a hydrogen atom, hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group independently, respectively. Either [however, ℓ at least] R^{18} or R^{19} hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group — it is — the monomeric mixture which contains three sorts of acrylic ester (meta—) of the acrylic ester which has an adamantane ring which has a substituent expressed (meta—) at least being given to copolymerization, and, (Meta) A manufacturing method of the high molecular compound for photoresist obtaining an acrylic ester copolymer.

[Claim 6] A resin composition for photoresist which contains a high molecular compound for photoresist and a photo-oxide generating agent of a statement in which paragraph of claims 1-4 at least.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the resin composition for photoresist containing the high molecular compound for photoresist used when performing micro processing of a semiconductor, etc., and the manufacturing method of this high molecular compound and the aforementioned high molecular compound.

[0002]

[Description of the Prior Art]The portion which shows substrate adhesion, and the portion which ****s with the acid by which it is generated from a photo-oxide generating agent by exposure, and becomes meltable to an alkali developing solution are required for the resin for photoresist used by a semiconductor manufacturing process. It has necessity that resin for photoresist has tolerance to the dry etching after exposure.

[0003]Conventionally, in acrylic resin for photoresist, the acrylic ester which has a lactone ring skeleton as a structure which gives substrate adhesion (meta) is proposed. The acrylic ester which has a cycloaliphatic hydrocarbon skeleton (meta) is proposed as a structure of having dry etching resistance. The acid desorption nature can attain at least these one ester bond part by using the 3rd class carbon. Therefore, it is possible by carrying out copolymerization of said two persons to obtain the polymer on which the function required as resin for photoresist was accumulated. However, actually, if it gives said two sorts of monomers to copolymerization since said lactone ring has the feature that polarity of a cycloaliphatic hydrocarbon skeleton is very low while polarity is dramatically high, It is easy to generate the polymer which has big composition distribution between molecules or by intramolecular without homopolymerizing the former by the former, tending to homopolymerize the latter by the latter, and as a result becoming a random polymer. If such polymer is used as resin for photoresist, when carrying out a spin coat to the substrate which is hard to dissolve in the solvent for photoresist, phase separation structure will be formed and it will be easy to produce fault, such as becoming an obstacle of formation of a resist pattern.

[0004]the monomer which has a lactone ring skeleton in order to give sufficient substrate adhesion — for example, about 50 mol % — although it is necessary to use, since a lactone ring is lacking in etching resistance, it is difficult to acquire etching resistance sufficient as polymer.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Therefore, the high molecular compound for photoresist whose purpose of this invention each monomer unit is not unevenly distributed and is a small high molecular compound of composition distribution between molecules and in intramolecular and which was moreover excellent in etching resistance, It is in providing the resin composition for photoresist containing the manufacturing method of this high molecular compound for photoresist, and this high molecular compound for photoresist.

[0006]While other purposes of this invention are excellent in the adhesion, alkali solubility, and etching resistance over a substrate, It is in providing the resin composition for photoresist containing the high molecular compound for photoresist which is easy to dissolve in the solvent for photoresist, and the manufacturing method of this high molecular compound for photoresist and this high molecular compound for photoresist.

[0007]

[Means for Solving the Problem]In order that this invention persons may attain the above-mentioned purpose, as a result of inquiring wholeheartedly, to acrylic ester which has a specific lactone ring skeleton (meta), and acrylic ester which has a specific alicyclic skeleton (meta). When copolymerization of the acrylic ester of 3 yuan which has a specific alicyclic skeleton which has said middle polarity of two ingredients as a third component (meta) was added and carried out, expansion of composition distribution between molecules of polymer to generate and in intramolecular could be avoided, and it found out that high etching resistance was acquired. This invention is completed based on these knowledge.

[0008] That is, this invention is the (A) following formula (1).

[Formula 9]

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ \text{CH}_{2} = C \\ \text{C} = 0 \\ 0 \\ R^{2} \\ \text{(R}^{3}R^{4}C)_{p} \\ \text{(R}^{7}R^{8})_{r} \\ \text{(R}^{5}R^{6}C)_{q} \\ \text{(CR}^{9}R^{10})_{s} \\ 0 \\ \text{(1)} \end{array}$$

(R^i shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^i shows the hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1–3. R^i , R^i , and R^{i0} show a hydrogen atom or a methyl group independently, respectively. p, q, r, and s show 0 or 1 independently, respectively. p+q+r+s=2–4 [however,] — it is — the acrylic ester which has a lactone ring of 5 expressed – 7 members (meta–), and the (B) following formula (2)

[Formula 10]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $(R^{1/2} - C - R^{1/3})_{\pm}$
 $C = 0$
 $C = 0$

 $(R^{11}$ shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{12} and R^{13} show the hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-3 independently, respectively. R^{14} shows the owner pons alicyclic hydrocarbon group of the carbon numbers 6-20. t— the integer of 0-5— being shown — the acrylic ester which has an owner pons alicyclic hydrocarbon group with which it is expressed (meta-), and a following formula (3)

[Formula 11]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

 $(R^{18}$ shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R^{16} — a methyl group or an ethyl group — being shown — at least one sort of acrylic ester (meta—) chosen from the acrylic ester which has an adamantane ring expressed (meta—), and (C) following formula (4)

[Formula 12]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

(R17 shows a hydrogen atom or a methyl group among a formula.) R18 and R19 are substituents combined with

the adamantane ring, and show a hydrogen atom, hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group independently, respectively. Either [however, / at least] R¹⁸ or R¹⁹hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group — it is the high molecular compound for photoresist produced by carrying out copolymerization of the monomeric mixture which contains three sorts of acrylic ester (meta-) of the acrylic ester which has an adamantane ring which has a substituent expressed (meta-) at least is provided.

[0009] A value of a solubility parameter by a method of Fedors of the aforementioned (meta) acrylic ester (C) is the range of $20.4(J/cm^3)^{1/2} - 23.5(J/cm^3)^{1/2}$, for example.

[0010] Rates of a copolymerization ratio of acrylic ester (meta) (C) may be 1 - 50-mol %, and weight average molecular weight of the above-mentioned high molecular compound for photoresist may be 1.000-500.000. A value of a solubility parameter according [the above-mentioned high molecular compound for photoresist] to a method of Fedors may be the range of 19.4(J/cm³)^{1/2} - 24.6(J/cm³)^{1/2}.

[0011] This invention Acrylic ester which has a lactone ring of 5 expressed with the (A) aforementioned type (1) - 7 members (meta), (B) acrylic ester which has an owner pons alicyclic hydrocarbon group expressed with said formula (2) (meta-). And at least one sort of acrylic ester chosen from acrylic ester which has an adamantane ring expressed with said formula (3) (meta), and (C) -- a monomeric mixture which contains at least three sorts of acrylic ester (meta-) of acrylic ester which has an adamantane ring which has a substituent expressed with said formula (4) (meta-) being given to copolymerization, and, (Meta) A manufacturing method of a high molecular compound for photoresist obtaining an acrylic ester copolymer is provided.

[0012] This invention provides the further above-mentioned high molecular compound for photoresist, and a resin composition for photoresist which contains a photo-oxide generating agent at least. In this specification, it may name generically "an acrylic (meta)", "acryloyl", and "methacryloyl one" "acryloyl (meta)" etc. for an "acrylic" and "methacrylic one."

[0013]

[Embodiment of the Invention] The acrylic ester which has a lactone ring of 5 - 7 member by which the high molecular compound for photoresist of this invention is expressed with the (A) aforementioned type (1) (meta), (B) the acrylic ester which has an owner pons alicyclic hydrocarbon group expressed with said formula (2) (meta-). And at least one sort of acrylic ester chosen from the acrylic ester which has an adamantane ring expressed with said formula (3) (meta) (meta), and (C) -- it comprises a copolymer of the monomeric mixture which contains at least three sorts of acrylic ester (meta-) of the acrylic ester which has an adamantane ring which has a substituent expressed with said formula (4) (meta-). When an isomer exists in the compound expressed with a formula (1), (2), (3), or (4), they can be used as independent or a mixture

[0014][(meta) acrylic ester (A)] In this invention, the compound expressed with a formula (1) is used as acrylic ester (meta) (A).

[0015] As a hydrocarbon group of the carbon numbers 1-3 in \mathbb{R}^2 , among a formula (1), For example, \mathbb{C}_{2-3} alkenyl groups, such as a C₁₋₃ alkyl group; allyl group of a methyl group, an ethyl group, a propyl group, and an isopropyl group; C3 cycloalkyl group of a cyclopropyl group, etc. are mentioned.

[0016] Also in the acrylic ester expressed with a formula (1) (meta), alpha-(meth)acryloyloxy gamma-butyrolactone (compound which are p=q=1 and r=s=0), beta-(meth)acryloyloxy

gamma-butyrolactone (compound which are p=r=1 and q=s=0), and beta-(meth)acryloyloxy delta-valerolactones (compound which are p=q=r=1 and s= 0) are preferred.

[0017]The following compounds are mentioned as a typical example of acrylic ester expressed with a formula (1) (meta).

[A-1] alpha-(meth)acryloyloxy gamma-butyrolactone (R 1 =H or CH $_3$, R 2 =R 3 =R 4 =R 5 =R 6 =H, p=q=1, r=s=0)

[A-2] alpha-(meth)acryloyloxy alpha-methyl-gamma-butyrolactone (R 1 =H or CH $_3$, R 2 =CH $_3$, R 3 =R 4 =R 5 =H, p=q=1, r=s=0)

[A-3] alpha-(meth)acryloyloxy beta, beta-dimethyl- gamma-butyrolactone (R¹=H or CH₃, R³=R⁴=CH₃, R²=R⁸=H, p=q=1, r=s=0)

[A-4] alpha-(meth)acryloyloxy alpha and beta, beta-trimethyl gamma-butyrolactone (R'=H or CH₃, R²=R²=CH₃, R³=R 6 =H, p=q=1, r=s=0)

[A-5] alpha-(meth)acryloyloxy gamma, gamma-dimethyl- gamma-butyrolactone (R'=H or CH₃, R 3 =R 3 =CH₃, R 2 =R 3 =R 4 =H, p=q=1, r=s=0)

[A-6] alpha-(meth)acryloyloxy alpha and gamma, gamma-trimethyl gamma-butyrolactone (R 1 =H or CH $_3$, R 2 =R 4 =CH $_3$, R 3 =R 4 =H, p=q=1, r=s=0)

[A-7] beta-(meth)acryloyloxy gamma-butyrolactone (R1=H or CH3, R2=R3=R4=R7=R8=H, p=r=1, q=s=0)

[A-8] beta-(meth)acryloyloxy beta-methyl-gamma-butyrolactone (R'=H or CH $_3$, R²=CH $_3$, R³=R'=R²=H, p=r=1, q=s=0)

[A=9] a beta-(meth)acryloyloxy beta-methyl-delta-valerolactone (R'=H \rightarrow or it CH- $_3$ (ing) and) R²=CH $_3$, R³=R⁴=R²=R²=R²=R³=R³=R, p=q=r=1, and s= 0

[0018] The acrylic ester expressed with a formula (1) (meta) gives a substrate adhesion function to polymer. [0019] The acrylic ester expressed with a formula (1) (meta) can be obtained by giving acrylic acid (meta) or its reactive derivative, and alcohol corresponding to the compound of a formula (1) to an esterification reaction. An esterification reaction can be performed by the method of the common use which used an acid catalyst, a base, a transesterification catalyst, etc.

[0020][(meta) acrylic ester (B)] In this invention, at least one sort of compounds chosen from the compound expressed with the compound and formula (3) which are expressed with a formula (2) are used as acrylic ester (meta) (B).

[0021]As a hydrocarbon group of the carbon numbers 1–3 in \mathbb{R}^{12} and \mathbb{R}^{13} , among a formula (2), For example, $\mathbb{C}_{2\rightarrow3}$ alkenyl groups, such as a $\mathbb{C}_{1\rightarrow3}$ alkyl group; allyl group of a methyl group, an ethyl group, a propyl group, and an isopropyl group; \mathbb{C}_3 cycloalkyl group of a cyclopropyl group, etc. are mentioned. To the owner pons alicyclic hydrocarbon ring (bridging ring) corresponding to the owner pons alicyclic hydrocarbon group of the carbon numbers 6–20 in \mathbb{R}^{14} . For example, an adamantane ring, a norbornane ring, a norbornane ring, a norbornane ring, a par hydrindene ring, a decalin ring, a par hydronalium fluorene ring. The owner pons alicyclic hydrocarbon ring of 2 – 4 rings, such as a perfluoro anthracene ring, $5.2.10^2$ and tricyclo [3] Deccan ring, $4.2.2.1^2$ and tricyclo [3] undecane ring, and a tetracyclo $[4.4.0.1^{2.5}, 1^{7.16}]$ dodecane, etc. are contained. Also in these owner pons alicyclic hydrocarbon rings, an adamantane ring, a norbornane ring, an isobornane ring, etc. are preferred. Said owner pons alicyclic hydrocarbon ring may have substrust, such as halogen atoms, such as alkyl groups (for example, $\mathbb{C}_{1\rightarrow4}$ alkyl group etc.), such as a methyl group, and a chlorine atom. [0022] the inside of a formula (2), and t — the integer of 0–5 — desirable — the integer of 0–5 — of 1 is

shown especially preferably.

[0023]The following compound is mentioned as a typical example of a compound expressed with said formula (2) or (3).

[B-1] 1-(1-(meth)acryloyloxy 1-methylethyl) adamantane (formula (2); R^{11} =H or CH₃, R^{12} = R^{13} =CH₃, an R^{14} =1-adamanthyl group, t= 1)

[B-2] 1-(1-(meth)acryloyloxy 1-ethylpropyl) adamantane (formula (2);R''=H or CH_3 , $R^{12}=R^{13}=CH_2CH_3$, an $R^{14}=1$ -adamanthyl group, t= 1)

[B-3] 1-(1-(meth)acryloyloxy 1-methylpropyl) adamantane (formula (2); R^{11} =H -- or it CH- $_3$ (ing) and) R^{12} =CH $_3$ CH $_3$, R^{13} =CH $_3$ and R^{14} =1-adamanthyl group, and t= 1

[B-4] 1-(1-(meth)acryloyloxy 1,2-dimethylpropyl) adamantane (formula (2), R^{11} =H -- or it CH- $_3$ (ing) and) R^{12} =CH(CH $_3$) $_{1}$, R^{13} =CH $_3$, an R^{14} =1-adamanthyl group, and t= 1

[B-5] 1-(meth)acryloyloxy adamantane (formula (2);R11=H or CH3, an R14=1-adamanthyl group, t= 0)

[B-6] 1-(meth)acryloyloxy 3,5-dimethyl adamantane (formula (2); R^{11} =H or CH $_3$, R^{14} =3,5-dimethyl adamantane 1-yl groups, t= 0)

[B-7] 2-(meth)acryloyloxy norbornane (formula (2);R¹¹=H or CH₃, an R¹⁴=2-norbornyl group, t= 0)

 $[B-8]\ 2-(meth) a cryloyloxy\ isobornane\ (formula\ (2); R^{11}=H\ or\ CH_3,\ an\ R^{14}=2-isobornyl\ group,\ t=0)$

[B-9] 2-(meth)acryloyloxy 2-methyladamantan (formula (3);R¹⁵=H or CH₂, R¹⁶=CH₂)

[B-10] 2-(meth)acryloyloxy 2-ethyl adamantane (formula (3);R¹⁵=H or CH₃, R¹⁶=CH₂CH₃)

[0024]Since the acrylic ester expressed with the formula (2) or (3) (meta) has an owner pons alicyclic hydrocarbon ring, it gives the etching-proof reproductive function to polymer. The compound of [t= 1-5] the compounds expressed with a formula (2) and the compound expressed with a formula (3) give the acid desorption reproductive function to polymer. (Meta) It is preferred to use at least one sort of monomers which give the acid desorption reproductive function as acrylic ester (B).

[0025] The acrylic ester expressed with the formula (2) or (3) (meta) can be obtained by giving acrylic acid (meta) or its reactive derivative, and alcohol corresponding to the compound expressed with the formula (2) or (3) to an esterification reaction. An esterification reaction can be performed by the method of the common use which used an acid catalyst, a base, a transesterification catalyst, etc.

[0026][(meta) acrylic ester (C)] In this invention, the compound expressed with a formula (4) is used as acrylic ester (meta) (C).

[0027]Among a formula (4), R^{18} and R^{19} are substituents combined with the adamantane ring, and show a hydrogen atom, hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group independently, respectively. However, either [at least] R^{18} or R^{19} is hydroxyl, an oxo group, or a carboxyl group. As for either [at least / especially] R^{18} or R^{19} it is preferred that it is hydroxyl.

[0028] The following compound is mentioned as a typical example of a compound expressed with a formula

(4). The numerical value behind a compound name is a value (two numbers show acrylate/methacrylate) of the below-mentioned solubility parameter.

[C-1] 1-(meth)acryloyloxy 3-hydroxy adamantane (R17=H or CH3, R18=OH, R19=H)

 $[22.79(J/cm^3)^{1/2}/22.21(J/cm^3)^{1/2}]$

[C-2] 1-(meth)acryloyloxy 3,5-dihydroxy adamantane (R 17 =H or CH $_3$, R 18 =R 19 =OH)

 $[25.12(J/cm^3)^{1/2}/24.43(J/cm^3)^{1/2}]$

- [C-3] 1-(meth)acryloyloxy adamantane 4-one (R 17 =H or CH $_3$, an R 18 =4-oxo group, R 19 =H)
- $[22.39(J/cm^3)^{1/2}/21.81(J/cm^3)^{1/2}]$
- [C-4] 1-(meth)acryloyloxy adamantane 4,6-dione (R¹⁷=H \rightarrow or it CH-3(ing) and) An R¹⁸=4-oxo group, an R¹⁹=6-oxo group [24.45(J/cm³)^{1/2}/23.76(J/cm³)^{1/2}]
- [C-5] 1-(meth)acryloyloxy 3-carboxy adamantane (R17=H or CH₃, R18=COOH, R19=H)
- $[21.91(J/cm^3)^{1/2}/21.64(J/cm^3)^{1/2}]$
- [C-6] 1-(meth)acryloyloxy 3,5-dicarboxy adamantane (R 17 =H or CH $_3$, R 18 =R 19 =COOH)
- $[23.33(J/cm^3)^{1/2}/23.02(J/cm^3)^{1/2}]$
- [C-7] 1-(meth)acryloyloxy 3-carboxy-5-hydroxy adamantane (R^{17} =H or it CH- $_3$ (ing) and) R^{18} =COOH, R^{19} =OH [24.17(J/cm 3) $^{1/2}$ /23.81(J/cm 3) $^{1/2}$]
- [0029]The acrylic ester expressed with a formula (4) (meta), Since it has the middle polarity of the aforementioned (meta) acrylic ester (A) and acrylic ester (meta) (B), have a function which controls the maldistribution of the composition distribution in the case of copolymerization, and. A substrate adhesion function is given to polymer, holding etching resistance, since it has the adamantane ring which the hydrophilic radical combined.
- [0030]The acrylic ester expressed with a formula (4) (meta) can be obtained by giving acrylic acid (meta) or its reactive derivative, and alcohol corresponding to the compound expressed with a formula (4) to an esterification reaction. An esterification reaction can be performed by the method of the common use which used an acid catalyst, a base, a transesterification catalyst, etc.
- [0031]In this invention, desirable (meta) acrylic ester (C), The value of the solubility parameter by the method [Polym. Eng. Sci., 14, and 147 (1974) references] of Fedors. (An "SP value" may only be called hereafter) is the range of 20.4(J/cm³)^{1/2}-23.5(J/cm³)^{1/2} [=10.0(cal/cm³)^{1/2}-11.5(cal/cm³)^{1/2}]. If such (meta) acrylic ester (C) is used, especially each monomeric unit can obtain the random copolymer distributed uniformly.
- [0032]In the high molecular compound for photoresist of this invention, although the rate of a copolymerization ratio of said three sorts of acrylic ester (meta) (A), (B), and (C) can be suitably set up according to those combination, (Meta) The ratio of acrylic ester (A), usually, 1–98-mol % desirable 10–80-mol % it being about 20–70 mol % still more preferably, and the ratio of acrylic ester (meta–) (B), usually, 1–98-mol % desirable 10–80-mol % it is about 20–70 mol % still more preferably the ratio of acrylic ester (meta–) (C) usually 1 50-mol % desirable 2 40-mol % it is about 3–30 mol % still more preferably.
- [0033]The high molecular compound for photoresist of this invention is a range which does not spoil the characteristic as resin for photoresist, and copolymerization of the monomers other than said three sorts of acrylic ester (meta) may be carried out. the rate of a copolymerization ratio of monomers other than said three sorts of acrylic ester (meta) for example, 0-10-mol % it is about 0-5 mol % preferably. [0034]The value of the solubility parameter according [the high molecular compound for photoresist of this invention] to the method [Polym. Eng. Sci., 14, and 147 (1974) references] of Fedors. It is preferred that (an "SP value" may only be called hereafter) is in the range of 19.4(J/cm³)^{1/2}–24.6(J/cm³)^{1/2} [=9.5(cal/cm³)^{1/2}-12(cal/cm³)^{1/2}].
- [0035] The resist coating which applied to the semiconductor substrate (silicon wafer) the resin composition

for photoresist containing the high molecular compound which has such a solubility parameter, and was formed, While excelling in the adhesive property (adhesion) over a substrate, a high-resolution pattern can be formed by alkaline development. If the value of a solubility parameter is lower than 19.4(J/cm³)^{1/2}, the adhesive property over a substrate will fall and the problem that a pattern separates by development and it does not remain will arise easily. If the value of a solubility parameter is larger than 24.6(J/cm³)^{1/2}, It becomes difficult easily for a substrate to crawl and to apply, and also the compatibility over an alkali developing solution becomes high, as a result, the soluble contrast of an exposure part and an unexposed part worsens, and resolution falls easily.

[0036]In this invention, the weight average molecular weight (Mw) of a high molecular compound is 3,000 to about 50,000 preferably 1,000 to about 500,000, for example, and molecular weight distribution (Mw/Mn) is 1.5 to about 3.5, for example. Said Mn shows a number average molecular weight (polystyrene conversion). [0037]The high molecular compound for photoresist of this invention The aforementioned (meta) acrylic ester (A), (Meta) It can obtain by carrying out copolymerization of the monomer mixture which contains three sorts of acrylic ester (meta) of acrylic ester (B) and (meta) acrylic ester (C) at least. (Meta) Acrylic ester (A), acrylic ester (meta) (B), and (meta) acrylic ester (C) can be used combining independent or 2 or more, respectively. Solution polymerization, melt polymerization, etc. can perform a polymerization by the conventional method used when manufacturing acrylic polymer.

[0038] The resin composition for photoresist of this invention contains the high molecular compound for photoresist and photo-oxide generating agent of said this invention.

[0039]The common use which generates acid efficiently by exposure as a photo-oxide generating agent thru/or a publicly known compound, For example, diazonium salt, idodnium salt (for example, diphenyliodo hexafluorophosphate etc.), sulfonium salt (for example, triphenylsulfonium hexafluoroantimonate.) sulfonic ester [, such as triphenylsulfoniumhexafluorophosphate and triphenyl sulfonium methanesulfonate.] [— for example, 1-phenyl-1-(4-methylphenyl) sulfonyloxy 1-benzoylmethane, 1,2,3-Trisul HONIRU oxymethyl benzene, 1,3-dinitro 2-(4-phenyl slufonyl oxymethyl) benzene,], such as 1-phenyl-1-(4-methylphenyl sulfonyl oxymethyl)-1-hydroxy-1-benzoylmethane, An oxa thiazole derivative, s-triazine derivative, disulfon derivatives (diphenyldisulfon etc.), an imide compound, oxime sulfonate, an diazonaphthoquinone, benzoin tosylate, etc. can be used. These photo-oxide generating agents are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0040]The amount of the photo-oxide generating agent used can be suitably chosen according to the intensity of the acid generated by optical exposure, the ratio of each monomeric unit in said high molecular compound, etc., For example, it can choose from the range of about 2–20 weight sections still more preferably one to 25 weight section preferably 0.1 to 30 weight section to said high molecular compound 100 weight section.

[0041] the resin composition for photoresist — alkalis soluble resin (for example, novolak resin.) phenol resin, imide resin, resin having carboxyl groups, etc. — etc. — an alkali soluble component. Colorant (for example, color etc.), organic solvents (for example, hydrocarbon, halogenated hydrocarbon, alcohols, ester species, amide, ketone, ether, cellosolves, carbitols, glycol ether ester, these mixed solvents, etc.), etc. may be included.

[0042] This resin composition for photoresist is applied on a substrate or a substrate, and after drying, a

detailed pattern can be formed in high accuracy via a predetermined mask by exposing a beam of light to a coat (resist film), forming a latent image pattern (or further after-exposure bake deed), and subsequently developing it.

[0043]As a substrate or a substrate, a silicon wafer, metal, a plastic, glass, ceramics, etc. are mentioned. Spreading of the resin composition for photoresist can be performed using the application means of common use of a spin coater, a dip coater, a roller coater, etc. 0.1–20 micrometers of thickness of a coat are about 0.3–2 micrometers preferably, for example.

[0044]The beam of light of various wavelength, for example, ultraviolet rays, X-rays, etc. can be used for exposure, and g line, I line, excimer lasers (for example, XeCl, KrF, KrCl, ArF, ArCl, etc.), etc. are usually used for it by the object for semiconductor resist. exposure energy — 1 – 1000 mJ/cm² — it is a 10 – 500 mJ/cm² grade preferably.

[0045] Acid generates from a photo-oxide generating agent by optical exposure, with this acid, protective groups (desorption nature group), such as a carboxyl group of the alkali solubility unit of said high molecular compound, **** promptly, for example, and the carboxyl group etc. which contribute to solubilization generate. Therefore, a predetermined pattern can be formed with sufficient accuracy by development by water or an alkali developing solution.

[0046]

[Effect of the Invention] Since copolymerization of three sorts of specific acrylic ester (meta) is carried out according to this invention, while having a random structure where each monomer unit is not unevenly distributed, high etching resistance is shown. While excelling in the adhesion, alkali solubility, and etching resistance over a substrate, it is easy to dissolve in the solvent for photoresist. Therefore, it can be conveniently used as resin for photoresist, and a detailed pattern can be formed in high accuracy.

[Example]Although this invention is explained more below at details based on an example, this invention is not limited at all by these examples. That it is behind a compound number (monomer number) with "methacrylate" shows the compound which has a methacryloyloxy group between two compounds belonging to each compound number. The number at the lower right of the parenthesis in a structural formula shows mol % of this monomeric unit.

[0048] Composition of resin of the example 1 following structure [Formula 13]

A refluxing pipe, a stirring child, and the method tap of three to the 100-ml round bottom flask which it had Monomer [A-9] (methacrylate) 1.74g (8.79 millimol), Monomer [B-1] (methacrylate) 1.84 g (7.02 millimol), monomer [C-1] (methacrylate) 0.42g (1.78 millimol), and 0.40 g of initiators (Wako Pure Chemical Industries make V-65) were put in, and it was made to dissolve in THF(tetrahydrofuran)16.00g. Then, after carrying out

the dry nitrogen purge of the inside of a flask, the temperature of the system of reaction was kept at 60 ***, and was stirred under a nitrogen atmosphere for 6 hours. It refined because drop reaction mixture on 500 ml of 9:1 mixed liquor of hexane and ethyl acetate and a ** exception carries out the produced sediment. It is desired resin by dissolving the collected precipitate in THF16.00g again after reduced pressure drying, and repeating above-mentioned precipitate refining operation. 2.75 g was obtained. When GPC analysis of the collected polymer was conducted, Mw (weight average molecular weight) was 6800, and molecular weight distribution (Mw/Mn) was 1.89. In 'H-NMR (inside of DMSO-d_q) analysis, 4.1 ppm, 3.3 ppm, and a signal strong against 4.6 ppm besides 1.5 – 2.5 ppm (broadcloth) were observed. The SP values of polymer are 22.23(J/em)^{1/2}.

[0049]Composition of resin of the example 2 following structure [Formula 14]

A refluxing pipe, a stirring child, and the method tap of three to the 100-ml round bottom flask which it had Monomer [A-7] (methacrylate) 1.06g (6.79 millimol), Monomer [B-9] (methacrylate) 2.26 g (9.66 millimol), monomer [C-1] (methacrylate) 0.68g (2.88 millimol), and 0.40 g of initiators (Wako Pure Chemical Industries make V-65) were put in, and it was made to dissolve in THF(tetrahydrofuran)16.00g. Then, after carrying out the dry nitrogen purge of the inside of a flask, the temperature of the system of reaction was kept at 60 ***, and was stirred under a nitrogen atmosphere for 6 hours. It refined because drop reaction mixture on 500 ml of 9:1 mixed liquor of hexane and ethyl acetate and a ** exception carries out the produced sediment. It is desired resin by dissolving the collected precipitate in THF16.00g again after reduced pressure drying, and repeating above-mentioned precipitate refining operation. 2.98 g was obtained. When GPC analysis of the collected polymer was conducted, Mw (weight average molecular weight) was 7300, and molecular weight distribution (Mw/Mn) was 2.04. In 'H-NMR (inside of DMSO-d_b) analysis, 4.1 ppm, 4.6 ppm, 3.3 ppm, and a signal strong against 5.3 ppm besides 1.5 - 2.5 ppm (broadcloth) were observed. The SP values of polymer are 22.03(J/cm³)^{1/2}.

[0050]About each of the polymer obtained in the evaluation test above-mentioned example, polymer 100 weight section and triphenylsulfonium hexafluoroantimonate 10 weight section were mixed with ethyl lactate, and the resin composition for photoresist of 17 % of the weight of polymer concentration was prepared. This resin composition for photoresist was applied to the silicon wafer by the spin coating method, and the 1.0-micrometer-thick photosensitive layer was formed. After prebaking for 150 seconds at the temperature of 100 ** on a hot plate and exposing by dose 30 mJ/cm² via a mask using a KrF excimer laser with a wavelength of 247 nm, postbake was carried out for 60 seconds at the temperature of 100 **. Subsequently, when negatives were developed for 60 seconds with the tetramethylammonium hydroxide solution of 0.3M and having been rinsed with pure water, in any case, a 0.20-micrometer line and space pattern was obtained.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145954 (P2002-145954A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

| (51) Int.Cl.7 | 織別記号 | FΙ | テーマコード(参考) | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| C08F 220/28 | | C 0 8 F 220/28 | 2 H 0 2 5 | |
| C08K 5/00 | | C 0 8 K 5/00 | 4 J 0 0 2 | |
| C 0 8 L 33/14 | | C 0 8 L 33/14 | 4 J 1 0 0 | |
| G 0 3 F 7/039 | 601 | G 0 3 F 7/039 | 601 | |
| H 0 1 L 21/027 | | H 0 1 L 21/30 5 0 2 R | | |
| | | 審查請求 未請求 | 請求項の数6 OL (全 9 頁) | |
| (21)出願番号 | 特願2000-343762(P2000-343762) | (71) 出願人 000002901 ダイセル化学工業株式会社 | | |
| | | | | |
| (22)出顧日 | 平成12年11月10日 (2000.11.10) | 大阪府堺市鉄砲町1番地 | | |
| | | (72)発明者 堤 聖 | (2)発明者 堤 聖晴 兵庫県姫路市網干区新在家940 | |
| | | 兵庫県 | | |
| | | (72)発明者 舩木 | 松木 克典 | |
| | | 兵庫県 | 兵庫県姫路市網干区新在家1367-5 | |
| | | (74)代理人 100101: | 100101362 | |
| | | 弁理士 | 弁理士 後藤 幸久 | |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用高分子化合物及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分 子内で組成分布の小さく、しかもエッチング耐性に優れ たフォトレジスト用高分子化合物を得る。

【解決手段】 (A) 式1、(B) 式2又は3の少なく とも1種、(C)式4の置換基を有するアダマンタン環 を有する (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メタ) アクリル砂エステルを含む単量体混合物を共重合したフ オトレジスト用高分子化合物。(R2、R12、R13 は水 素又は炭素数1~3の炭化水素基。R14は炭素数6~2 0の有橋脂環式炭化水素基。R 16 はメチル基等。R 18 、 R19 は、水素、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキ シル基。但し、R18 及びR19 は同時に水素ではない。 p、q、r及びsは0又は1。但し、p+q+r+s= $2 \sim 4$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記式(1) 【化1】

$$\begin{array}{c} R^1 \\ \text{CH}_2 = C \\ \text{C} = 0 \\ \text{O} \\ \text{R}^2 \\ \left\langle R^3 R^4 C_p \right\rangle \left\langle C R^7 R^8 \right\rangle_r \end{array}$$

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示す。 R^2 は水素 原子又は炭素数1~3の炭化水素基を示す。 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^5 、 R^8 、 R^8 处び R^{10} は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示す。R、Q r 及びSは、それぞれ独立に、Q 又は 1 を示す。Q L Q P Q F Q T Q P

[(k2]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、 R¹¹ は水素原子又はメチル基を示す。 R¹² 及び R¹³ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数1~3の 炭化水素基を示す。 R¹⁴ は従来数6~20の有機脂環式 炭化水素基を示す。 t は0~5の整数を示す)で表され る有額脂調式炭化水素基を有する (メタ) アクリル酸エ ステル、及び下記式(3)

[化3]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 R^{16}
(3)

(式中、R^B は水素原子又はメチル基を示す。R^B はメ チル基又はエチル基を示す)で表されるアダマンタン環 を有する (メタ) アクリル酸エステルから選択された少 なくとも 1種の (メタ) アクリル酸エステル、及び (C) 下記式 (4)

(C) LEET (4

[化4]

$$CH_2 = C \begin{pmatrix} R^{*} \\ C = 0 \end{pmatrix}$$
 $R^{18} \begin{pmatrix} R^{19} \\ R^{19} \end{pmatrix}$

(式中、R¹⁷は水素原子又はメチル基を示す。 R¹⁸ 及び R¹⁸は、アダマンタン環に結合している置換基であり、 それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基 50

又はカルボキシル基を示す。但し、R[®]及びR[®]の少な くとも一方は、ヒドロキシル基、オキツ基又はカルボキ シル基であり で表される影響を有する アタリカン 環を有する (メタ) アクリル酸エステルの3 種の (メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共成合して得られるフォトレジスト用高分子化合物。 [請求項2] (メタ) アクリル酸エステル (C) の下 e d or s の方法による浩解度パラメーターの値が2 0.4 (J/cm³) ¹² ~ 23.5 (J/cm³) ¹² の 範囲である請求項1 記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項3】 (メタ) アクリル酸エステル (C) の共 重合比率が1~50モル%であり、重量平均分子量が 1,000~500,000である請求項1記載のフォ トレジスト用高分子化合物。

20 【請求項5】 (A) 下記式(1)

【化5】

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ C_{1} = C \\ C = 0 \\ 0 \\ R^{2} \\ (R^{3}R^{4}C)_{p} \\ (R^{5}R^{6}C)_{q} \\ C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3} \\ C_{4} \\ C_{5} \\ C_{7} \\ C_{8} \\ C_{1} \\ C_{8} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3} \\ C_{4} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3} \\ C_{4} \\ C_{5} \\ C_{6} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3} \\ C_{4} \\ C_{5} \\ C_{5} \\ C_{6} \\ C_{6} \\ C_{7} \\ C_{8} \\ C_{8} \\ C_{8} \\ C_{1} \\ C_{8} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{1} \\ C_{2} \\ C_{3} \\ C_{4} \\ C_{5} \\ C_{6} \\$$

(式中、R'ほれ米銀門子以はメチル基を示す。R'は水素 原子又は炭素数1~3の炭化水素基を示す。R³、R⁴、 R⁵、R⁶、R⁶、R⁸、R⁸及びR⁸は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示す。p、q、r 及びs は、それぞれ独立に、0又は1を示す。但し、p+q+ r+s=2~4である)で表される5~7歳のラクトン 環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B)下配式 (2)

【化6】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $(R^{12} - C - R^{13})_{t}$
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、R** Lt木素原子又はメチル基を示す。R** 及び R** は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数1~3の 炭化水素基を示す。R** は炭素数6~20の有極脂環式 炭化水素基を示す。1 は0~5の整数を示す)で表され る有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エ ステル、及び下温式(3)

【化7】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、R^B は水素原子又はメチル基を示す。R^B はメ チル基又はエチル基を示す)で表されるアダマンタン環 を有する (メタ) アクリル酸エステルから選択された少 なくとも1種の (メタ) アクリル酸エステル、及び (C) 下記式 (4)

【化8】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、取りは水素原子又はメチル基を示す。 R^B 及び R^B は、アダマンタン環に結合している間換基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基 又はカルボキシル基を示す。但し、R^B 及びド^B の少な 2 くとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基である。で表される間微基を有するアグマンタン環を有する (メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステル火重合を単量体混合物を共重合に付して、(メタ)アクリル酸エステル火重合体を得ることを特徴とするフォトレジスト用高分子化合物の製造方法。

【請求項6】 請求項1~4の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工な どを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物 と、この高分子化合物の製造方法、及び輸記の高分子化 合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程で用いられるフォトレジ スト用樹脂は、基板密着性を示す部分と、露光によって 光酸発生期から発生する酸により影雕してアルカリ現像 液に対して可溶になる部分が必要である。また、フォト レジスト用機脂は、露光後のドライエッチングに対して 耐性を育することが必要がある。

[0003] 従来、アクリル系のフォトレジスト用船間では、基板密着性を付与する構造としてラクトン環得物を有する (メタ) アクリル酸エステルが動力継楽されている。また、ドライエッチング耐性を育する構造として、脂環式症化水素学校を育する (メタ) アクリル酸エステル版が提案されている。酸脱離性は、これらの少なくとも一方のエステル総合部位を第3級炭素にすることで達 20

成できる。除って、前記二者を共重合することにより、 フォトレジスト用樹脂として必要な機能が集積されたボ リマーを得ることが可能である。しかし、実際には、前 記ラクトン環は極性が非常に高い一方、 監視が上端に低いという特徴を持っていることか。 6 前記2 陸ル甲量体を上端合に付すと、前名を約者、 後者は後者で単独重合する傾向があり、その結果、ラン ダム重合体にはならずに分子間或いは分子内で大きな組 成分布を持つポリマーが生成しやすい。このようなポリ マーをフォトレジスト用機関として削いると、フォトレ ジスト用の溶媒に溶解しにくい、基核にスピンコートす る際に相分構構造を形成してレジストパターンの形成の 簡素となる等の不具合が生じやすい。

【0004】また、十分な基板密着性を付与するために は、ラクトン環骨格を育する単量体を例えば50モル% 近く用いる必要があるが、ラクトン環はエッチング耐性 に乏しいため、ポリマーとして十分なエッチング耐性を 得ることは困難である。

[0005]

【毎明が解決しようとする課題】従って、本界押の目的 は、答モノマーユニットが信在せず、分子間や分子内で 相成分布の小さい高分子化合物であって、しかもエッチ ング耐性に優れたフォトレジスト用高分子化合物と、該 フォトレジスト用高分子化合物の製造方法。及び該フォ トレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂 組成物を提供することにある。

【0006】 本発卵の他の目的は、基板に対する密管 性、アルカリ可溶性及びエッチン/溶性に優化るとも に、フォトレジスト用溶板に溶解しやすいフォトレジス ト用高分子化合物と、該フォトレジスト用高分子化合物 の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含 むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。 【0007】

(環題を解決するための手段) 本発明者らは、上記目的 を遠皮するため就意能計した結果、特定のラクトン環号 格を有する (メタ) アクリル酸エステルと特定の胎環式 骨格を有する (メタ) アクリル酸エステルと特定の胎環式骨格 と行前記 2 成分の中間の極性を持つ特定の胎環式骨格 を有する (メタ) アクリル酸エステルを加えて3 元共重 合すると、生成するポリマーのタ子間及び分子にはごよ る組成分布の拡大を回避できると共に、高いエッチング 耐性が得られることを見出した。本発明はこれらの知見 になるいであるメリーである。

【0008】すなわち、本発明は、(A)下記式(1) 【化9】

(式中、R1は水素原子又はメチル基を示す。R2は水素 原子又は炭素数1~3の炭化水素基を示す。R3、R4、 R5、R6、R7、R8、R9及びR10 は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示す。 p、 q、 r 及び s は、それぞれ独立に、0又は1を示す。但し、p+q+ $\Gamma + s = 2 \sim 4$ である) で表される $5 \sim 7$ 員のラクトン 環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B)下記式 (2)

【化10】

$$\begin{array}{c} \mathbb{R}^{11} \\ \mathbb{C} \mathbb{H}_2 = \mathbb{C} \\ \mathbb{C} = \mathbb{O} \\ \mathbb{O} \\ \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C}^{13} \mathbb{C}_{\mathbb{C}} \\ \mathbb{R}^{14} \end{array} \tag{2}$$

(式中、R11 は水素原子又はメチル基を示す。R12 及び R13 は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数1~3の 炭化水素基を示す。R14 は炭素数6~20の有橋脂環式 炭化水素基を示す。 t は0~5の整数を示す) で表され る有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エ ステル、及び下記式(3)

RE111

$$CH_2 = C C = 0$$

$$C = 0$$

$$R^{16}$$

$$(3)$$

(式中、R15 は水素原子又はメチル基を示す。R16 はメ チル基又はエチル基を示す) で表されるアダマンタン環 を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少 なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び (C) 下記式(4)

[(k:12]

$$CH_2 = C_1^{''}$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、R17 は水素原子又はメチル基を示す。R18 及び R 19 は、アダマンタン環に結合している置換基であり、 それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基 又はカルボキシル基を示す。但し、R18 及びR19 の少な くとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキ シル基である)で表される置換基を有するアダマンタン 50

環を有する (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物を 提供する。

【0009】前記(メタ)アクリル酸エステル(C)の Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、 例えば20.4 (J/cm³) 1/2~23.5 (J/cm 3) 1/2 の節囲である。

【0010】上記のフォトレジスト用高分子化合物は、 (メタ) アクリル酸エステル (C) の共重合比率が1~ 50モル%であり、重量平均分子量が1,000~50 0,000であってもよい。また、上記フォトレジスト 用高分子化合物は、Fedorsの方法による溶解度パ ラメーターの値が19、4 (I/cm3) 1/2~24、6 (J/cm3) 1/2 の範囲であってもよい。

【0011】本発明は、また、(A) 前記式(1) で表 される5~7員のラクトン環を有する(メタ)アクリル 酸エステル、(B) 前記式(2)で表される有橋脂環式 炭化水素基を有する (メタ) アクリル酸エステル、及び 20 前記式(3)で表されるアダマンタン環を有する(メ タ) アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種 の (メタ) アクリル酸エステル、及び (C) 前記式

(4) で表される置換基を有するアダマンタン環を有す る (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メタ) アクリ ル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合に 付して、(メタ) アクリル酸エステル共電合体を得るこ とを特徴とするフォトレジスト用高分子化合物の製造方 法を提供する。

【0012】本発明は、さらに、上記のフォトレジスト 30 用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレ ジスト用樹脂組成物を提供する。なお、本明細書では、 「アクリル」と「メタクリル」とを「(メタ)アクリ ル」、「アクリロイル」と「メタクリロイル」とを 「(メタ)アクリロイル」等と総称する場合がある。

[0013] 【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子 化合物は、(A) 前記式(1) で表される5~7員のラ クトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B) 前記式(2)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する 40 (メタ)アクリル酸エステル、及び前記式(3)で表さ れるアダマンタン環を有する (メタ) アクリル酸エステ ルから選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸 エステル B75(C) 前記式(4) で表される置換基を 有するアダマンタン環を有する(メタ)アクリル砂エス テルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも 含む単量体混合物の共重合体で構成されている。なお、

において異性体が存在する場合には、それらは単独で又 【0014】「(メタ) アクリル酸エステル(A)] 本

は混合物として使用できる。

式(1)、(2)、(3)又は(4)で表される化合物

発明では、(メタ) アクリル酸エステル(A) として式(1) で表される化合物を用いる。

【0015】式(1)中、R²における炭素数1~3の 炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プ ロビル基、イソプロビル基のC₁₃アルキル基;アリル 基等のC₂₃アルケニル基;シクロプロビル基のC₃シク ロアルキル基などが挙げられる。

【0 0 1 6] 式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルの中でも、 α - (メタ)アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン類(p=q=1、, r=s=0である化 6合物)、 β - (メタ)アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン類(p=r=1、q=s=0である化合物)、 β - (メタ)アクリロイルオキシー δ - バレロラクトン類(p=q=r=1、s=0である化合物)などが好ましい。

【0017】式 (1) で表される (メタ) アクリル酸エステルの代表的な例として以下の化合物が挙げられる。 [A-1] α (メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン (R^1 = H又はC H $_3$ 、 R^2 = R^3 = R^4 = R^6 = H, p = q = 1, r = s = 0

[A-2] α - (メタ) アクリロイルオキシー α -メチル - y - プチロラクトン (R¹= H又はCH₃、R² = C H₃、R³ = R⁴ = R⁵ = R⁶ = H、p = q = 1、r = s = α)

[A-3] α - (メタ) アクリロイルオキシー β , β - ジメチルー y - ブチロラクトン(R¹ = H又はCHs、R³ = R⁴ = C H3、R² = R⁵ = R⁶ = H、p = q = 1、r = s = 0)

[A-4] α - (メタ) アクリロイルオキシー α , β , β -トリメチルー γ - ブチロラクトン (R1 = H又はC H 3, R^2 = R^3 = R^4 = C H 3, R^5 = R^6 = H, p = q = 1, r = s = 0

[A-6] α - (メタ) アクリロイルオキシー α , y, y - トリメチル-y - ブチロラクトン (R^1 = H又はC H₃、 R^2 = R^6 = R^6 = C H₃、 R^3 = R^4 = H、p = q = 1, r = s = 0

[A-7] β - (メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン (R^1 = H又はC H3、 R^2 = R^3 = R^4 = R^7 = R^8 = H、 p = r = 1、 q = s = 0

[A-8] β - (メタ) アクリロイルオキシー β - メチル - γ - ブチロラクトン (R^1 = H又献C H 3 , R^2 = C H 3 , R^3 = R^4 = R^7 = R^8 = H , p = r = 1 , q = s = 0

 =1, s=0

【0018】式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルはポリマーに基板密着性機能を付与する。

8

【0019】式(1)で表される(メタ)アクリル酸工 ステルは、(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体 と、式(1)の化合物に対応するアルコールとをエステ ル化反応に付すことにより得ることができる。エステル 化反応は、酸触線、延延、エステル交換触媒等を用いた 個用の方法により行うことができる。

【0020】 [(メタ) アクリル酸エステル (B)]本 発明では、(メタ) アクリル酸エステル (B) として式 (2) で表される化合物及び式(3) で表される化合物 から選択された少なくとも1種の化合物を用いる。

【0021】式(2)中、R¹²、R¹³における炭素数1 ~3の炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基のC13 アルキル基; アリル基等のC2-3 アルケニル基;シクロプロピル基の C3シクロアルキル基などが挙げられる。 R11 における 炭素数6~20の有橋脂環式炭化水素基に対応する有橋 脂環式炭化水素環(橋かけ炭素環)には、例えば、アダ マンタン環、ノルボルナン環、ノルボルネン環、ボルナ ン環、イソボルナン環、パーヒドロインデン環、デカリ ン環、パーヒドロフルオレン環、パーフルオロアントラ セン環、トリシクロ「5, 2, 1, 02,6] デカン環、 トリシクロ [4. 2. 2. 12.5] ウンデカン環、テト ラシクロ [4, 4, 0, 12,5, 17,10] ドデカンなど の2~4環の有橋脂環式炭化水素環などが含まれる。こ れらの有機脂環式炭化水素環の中でも、アダマンタン 環、ノルボルナン環、イソボルナン環等が好ましい。前

30 記有橋脂環式炭化水素環は、メチル基等のアルキル基 (例えば、Cia アルキル基など)、塩素原子等のハロ ゲン原子などの置換基を有していてもよい。 [0022]式(2)中、tは0~5の整数、好ましく

は0~2の整数、特に好ましくは0又は1を示す。 【0023】前記式(2)又は(3)で表される化合物 の代表的な例として下記の化合物が挙げられる。

[B-1] $1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルエチル) アダマンタン (式 (2)); <math>R^{11} = H \nabla k$ $C H_3$ 、 $R^{12} = R^{13} = C H_3$ 、 $R^{14} = 1- \mathcal{P} \vec{\nabla} \vec{\nabla} \mathcal{Y} \mathcal{F} \mathcal{V}$ 40 基、t = 1)

[B-2] $1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1- エチルプロゼル) アダマンタン (式 (2): R^{II} = H又 は C H₃、R^{I2} = C H₂ C H₃、R^{II} = <math>1- \mathcal{P} \mathcal{G} \mathcal{T}$ ンチル基、t=1

[B-3] $1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルプロピル) アダマンタン (式 (2) ; <math>R^{11}=H$ 又 は CH_3 、 $R^{12}=CH_2$ CH_3 、 $R^{13}=CH_3$ 、 $R^{14}=1-$ アグマンチル基、t=1)

[B-4] 1 − (1 − (メタ) アクリロイルオキシー1, 50 2 −ジメチルプロピル) アダマンタン(式(2); R¹¹ = H又はCH3、R¹² = CH (CH3) 2、R¹³ = CH3、

[B-5] 1 - (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (式(2); R^{II} = H又はCH₃、R^M = 1 − アダマン チル基、1 = 0)

 $R^{14} = 1 - アダマンチル基、 t = 1)$

[B-6] 1- (メタ) アクリロイルオキシー3, 5-ジメチルアダマンタン (式(2); $R^{11}=H$ 又は CH_3 、 $R^{14}=3$, 5-ジメチルアダマンタン-1-イル基、t=0)

[B-7] 2- (メタ) アクリロイルオキシノルボルナン (式(2); R^{II}=H又はCH₃、R^{I4}=2-ノルボルニル基。1=0)

[B-8] 2- (メタ) アクリロイルオキシイソボルナン (式(2); R^{II}=H又はCH₃、R^{II}=2-イソボル ニル基、t=0)

[B-0] 2- (メタ) アクリロイルオキシ-2-メチル アダマンタン(式(3); R¹⁵=H又はCH₃、R¹⁶= CH₂)

[B-10] 2- (メタ) アクリロイルオキシ-2-エチル アダマンタン (式(3); R¹⁵ = H又はCH₃、R¹⁶ = CH₂ CH₃)

【0024】式(2) 又は(3)で表される(メタ)ア リル酸エステルは、有線頭環式炭化水素環を有するので、ボリマーに耐エッチング性機能を付与する。また、 式(2)で表される化合物のうち 1 = 1 ~ 5 の化合物、 及び式(3)で表される化合物は、ボリマーに酸脱離性 機能を付与する。(メタ)アクリル酸エステル(8)と しては、酸炭離性機能を付与するモノマーを少なくとも 1 締件用まるの好字より、

[00025]式(2)又は(3)で表される(メタ)ア 20 クリル酸エステルは、(メタ)アクリル酸又はその反応 性誘導体と、式(2)又は(3)で表される化合物に対 応するアルコールとをエステル化反応に付すことにより 得ることができる。エステル化反応は、酸触媒、塩基、 エステル交換触媒等を用いた慣用の方法により行うこと ができる。

【0026】 [(メタ) アクリル酸エステル (C)] 本 発明では、 (メタ) アクリル酸エステル (C) として式 (4) で表される化合物を用いる。

[0027]式(4)中、R¹⁸及びR¹⁰は、アダマンタ 40 ン環に結合している置換基であり、それぞれ独立に、水 素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基 を示す。但し、R¹⁸及びR¹⁰の少なくとも一方は、ヒド ロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基である。R¹⁸ 及びR¹⁰の少なくとも一方は、特にヒドロキシル基であ るのが好ましい。

【0028】式(4)で表される化合物の代表的な例と して下記の化合物が挙げられる。なお、化合物名の後ろ の数値は後述の溶解取バラメーターの値(2つの数字は アクリレート/メタクリレートを示す)である。 [C-1] 1- (メタ) アクリロイルオキシー3-ヒドロキシアダマンタン (R 17 =H又はC H₃、 R 18 =O H₄、 R 19 =H) [2 2. 79 (J/c m^3) $^{1/2}/2$ 2. 21 (I/c m^3) $^{1/2}$]

10

[C-2] 1- (メタ) アクリロイルオキシー3, 5-ジ ヒドロキシアダマンタン(R^{II} = H又はC H₃、R^{I8} = R^{I9} = OH) [25.12 (J/c m³) $^{1/2}$ /2 4.4 3 (J/c m³) $^{1/2}$

[C-3] 1- (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン 0 - 4-オン (R^{II} = H X & C H₃ 、 R^{I8} = 4 - オキソ 基、R^{I9} = H) [22、39 (J/c m³) ^{1/2} /21. 81 (1/c m³) ^{1/2}]

[C-4] 1- (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン -4,6-ジオン (R^{II} = H X LiC Ha、 R^{IS} = 4-オ キソ基、 R^{IS} = 6-オキソ基) [24,45 (J/cm³) 1/2/23,76 (J/cm³) 1/2]

[C-5] 1 - (メタ) アクリロイルオキシー 3 -カルボ キシアダマンタン(R^{I7} = H 又 は C H₃、 R¹⁸ = C O O H、 R¹⁹ = H) [2 1. 9 1 (J/c m³) $^{1/2}$ / 2 1. 6 4 (J/c m³) $^{1/2}$]

[C-6] $1 - (\cancel{A}\cancel{9})$ アクリロイルオキシー3, $5 - \cancel{9}$ カルボキシアダマンタン ($\mathbb{R}^{19} = \mathbb{H} \mathbb{X}$ kC \mathbb{H}_3 、 $\mathbb{R}^{18} = \mathbb{R}^{19} = \mathbb{C}$ OO \mathbb{H}) [23.33 (\mathbb{J}/\mathbb{C} m³) \mathbb{H}^2/\mathbb{C} 3.02 (\mathbb{J}/\mathbb{C} m³) \mathbb{H}^2/\mathbb{C}

【0029】式(4)で表される(メタ)アクリル酸エステル(A) ステルは、前記(メタ)アクリル酸エステル(A) (メタ)アクリル酸エステル(B)の中間の極性を有す るため、共重合の際の組成分布の偏在を抑制する機能を 有すると共に、観水性基の結合したアダマンタン環を有 しているため、エッチング耐性を保持しつつ、ポリマー に基係密着性機能を付与する。

【0030】式(4)で表される(メタ)アクリル酸エステルは、(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体と、式(4)で表される化合物に対応するアルコールとをエステル化反応に付すことにより得ることができる。エステル化反応は、耐砂螺、塩焦、エステル火炭粉燥紫ラを用いた関用の方法により行うことができる。

【0031】 本発明において、好ましい(メタ)アクリ ル酸エステル(C)は、Fedorsの方法 [Polym. E 雨。Sci., 4、147(1974)参照 による溶解度がラメー ターの値(以下、単に「S P値」と称することがある) が20、4(J / c m³)¹² ~ 23、5(J / c m³) ¹² [= 10、0 (c a 1 / c m²) ¹² ~ 11.5 (c a 1 / c m³) ¹²] の範囲である。このような(メタ) アクリル酸エステル(C)を用いると、特に名モノマー 単位が9ーでがし、たランス大理合体を得ることがで

きる.

【0032】本発明のフォトレジスト用高分子化合物において、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル

11

(A)、(B) 及び(C) の共重合比率は、それらの租 か合わせに応じて適宜設定できるが、(メタ)アクリル 酸エステル(A) の比率は、通常1~98モル%、好ま しくは10~80モル%、さらに好ましくは20~70 モル%程度であり、(メタ)アクリル億エステル(B) の比率は、通常1~98モル%、好ましくは10~80 モル%、さらに好ましくは20~70モル%程度であ り、(メタ)アクリル酸エステル(C) の比率は、通常 1~50モル%、好ましくは2~40モル%、さらに好ましくは2~40モル%、さらに好ましくは2~40モル%、さらに好ましくは2~40モル%、さらに好ましくは3~30モル%程度である。

【0033】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、フォトレジスト用樹脂としての特性を損なわない範 囲で、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモ ノマーが共量合されていてもよい。前記3種の(メタ) アクリル酸エステル以外のモノマーの共重合比率は、例 えば0~10モル%、好ましくは0~5モル%程度であ る。

【0034】本祭明のフォトレジスト用高分子化合物は、Fedorsの方法 [Polym. Eng. Sci., 14, 147はは、Fedorsの方法 [Polym. Eng. Sci., 14, 147は「F947]が、F95年に「F94年にF94年に「F94年に「F94年にF94年

【0035】このような溶解処パラメーターを有する高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を半導体 超板(シリコンウェハー)に整布して形成されたレジスト ト塗膜は、基板に対する接着性(密着性)に優れるとと もに、アルカリ現像により解像度の高いパターンを形成 することができる。溶解度パラメーターの値が19.4 (J/c m³) 1² より低いと、基板に対する接着性が低 下して、現像によりパターンが動がれて残らないという 問題が起こりやすい。また、溶解度パラメーターの値が 24.6 (J/c m³) 1² より大きいと、基板にはじか れて途市することが困難になりをすい上、アルカリ現像 液に対する銀和性が高くなり、その結果、霧光部と未露 光郎の溶解性のコントラストが悪くなって解像度が低下 40

【0036】 本発明では、高分子化合物の重単平均分子 量(Mw)は、例えば1,000~500,000程 度、好ましくは3,000~50,000程度であり、 分子量分布(Mw/Mn)は、例えば1.5~3.5程 度である。なお、前記Mnは数平均分子壁(ポリスチレ 火物章)を示す。

【0037】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、前記(メタ)アクリル酸エステル(A)、(メタ) アクリル酸エステル(B)、及び(メタ)アクリル酸エ 50 12

ステル (C) の3種の (メタ) アクリル酸エステルを少なくとも含むモノマー混合物を共電合させることにより
得ることができる。 (メダ) アクリル酸エステル

(A)、(メタ) アクリル酸エステル(B)、及び(メ タ) アクリル酸エステル(C) は、それぞれ単独で又は 2以上を組み合わせて使用できる。重合は、溶液重合、 溶酸重合など、アクリル系ポリマーを製造する際に用い る慣用の方法により行うことができる。

【0038】本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、 前記本発明のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生

剤とを含んでいる。 【0039】光酸発生剤としては、露光により効率よく 酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニ ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへ キサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例 えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネ ートなど)、スルホン酸エステル[例えば、1-フェニ 20 ルー1-(4-メチルフェニル) スルホニルオキシー1 -ベンゾイルメタン、1,2,3-トリスルホニルオキ シメチルベンゼン、1、3-ジニトロ-2-(4-フェ ニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1-フェニル -1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシー1ーベンゾイルメタンなど]、オキ サチアゾール誘導体、s-トリアジン誘導体、ジスルホ ン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合 物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベン ゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生 剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0040】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単位の比率を定比を比で適宜無限でき、例えば、前記高分子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好しくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重量部程度の範囲から選択できる。

【0041】フォトレジスト用樹陰組成物は、アルカリ 可溶性樹脂(例えば、ノボラック機関、フェノール樹 脈 イミド樹脂、カルボキシル基合有樹脂など)などのアルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素が、ルニル・樹、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んでいてもよい。

【0042】このフォトレジスト用朝胎組成物を基材又 は基板上に達布し、乾燥した後、所定のマスクを介し て、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さら に露光後ベークを行い)潜像がターンを形成し、次いで 現像することにより、機細なパターンを形成し、流いで できる。

【0043】 基材又は基板としては、シリコンウエハ、 金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げら れる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコ ータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布 手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば 1~20 um、好ましくは0.3~2 um程度であ

【0044】露光には、種々の波長の光線、例えば、紫 外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通 10 常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeC 1、KrF、KrC1、ArF、ArC1など)などが 使用される。露光エネルギーは、例えば 1~1000m J/cm²、好ましくは10~500mJ/cm²程度で ある。

【0045】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、 この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶 性ユニットのカルボキシル基等の保護基(脱離性基)が 域やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等 が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現 20 像により、所定のパターンを精度よく形成できる。

[0046]

【発明の効果】本発明によれば、特定の3種の(メタ) アクリル酸エステルを共重合させるので、各モノマーユ ニットが偏在しないランダムな構造を有するとともに、 高いエッチング耐性を示す。また、基板に対する密着 性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるととも に、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすい。そのため、 フォトレジスト用樹脂として好適に使用でき、微細なパ ターンを高い精度で形成することができる。 [0047]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定 されるものではない。なお、化合物番号(モノマー番 号) の後ろに「メタクリレート」とあるのは、各化合物 番号に属する2つの化合物のうちメタクリロイルオキシ 基を有する化合物を示す。構造式中の括弧の右下の数字 は該モノマー単位のモル%を示す。 【0048】実施例1

下記構造の樹脂の合成

[化13]

環流管、推律子、3方コックを備えた100ml丸底フ ラスコにモノマー [A-9] (メタクリレート) 1, 74

g (8. 79ミリモル)、モノマー [B-1] (メタクリ レート) 1. 84g (7. 02ミリモル)、モノマー [C-1] (メタクリレート) O. 42g (1.78ミリ モル) 及び開始剤(和光純薬工業製V-65) 0. 40 gを入れ、THF (テトラヒドロフラン) 16.00g に溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈殿物を濾別すること で精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度TH F16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り 返すことにより所望の樹脂 2. 75gを得た。回収し たポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分 子量) が6800、分子量分布(Mw/Mn) が1.8 9 であった。1 H-NMR (DMSO-ds中) 分析で は、1、5-2、5 p p m (プロード) のほか、3、3 ppm、4. 1 ppm、4. 6 ppmに強いシグナルが 観測された。ポリマーのSP値は22.23 (J/cm 3) 1/2 である。

14

【0049】実施例2

下記構造の樹脂の合成 [(E14]

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコにモノマー [A-7] (メタクリレート) 1.06 g (6. 79ミリモル)、モノマー [B-9] (メタクリ レート) 2. 26g (9. 66ミリモル)、モノマー [C-1] (メタクリレート) O. 68g(2.88ミリ モル) 及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0.40 gを入れ、THF (テトラヒドロフラン) 16.00g に溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間槽拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈殿物を濾別すること 40 で精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度TH F 1 6. 0 0 g に溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り 返すことにより所望の樹脂 2.98gを得た。回収し たポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分 子量) が7300、分子量分布(Mw/Mn) が2.0 4 であった。1 H-NMR (DMSO-ds中) 分析で は、1.5-2.5 ppm (プロード) のほか、3.3 ppm, 4. 1ppm, 4. 6ppm, 5. 3ppm ← 強いシグナルが観測された。ポリマーのSP値は22. 03 (J/cm3) 1/2 である。

【0050】評価試験

上記実施例で得られたポリマーのそれぞれについて、ポリマー100重量部とトリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート10重量部とを乳酸エチルと混合して、ポリマー濃度17重量%のフォトレジスト用樹脂組成物を割製した。このフォトレジスト用樹脂組成物をシリコンウエハーにスピンコーティンが試により途布し、厚み1.0μmの感光層を形成した。ホットブレトで温度100でで150秒間プリベークした後、波

長 247 n mの K r F エキシマレーザーを用い、マスクを介して、照射量 3 0 m J / cm $^{-2}$ 電流化 た後、10 0 $^{-2}$ の温度で 6 0 秒間ポストベークした。次いで、0 3 Mのテトラメチルアンモニウム ヒドロキンド 水溶液に より 6 0 秒間思像し、続いてリンスしたところ、何れの 場合も、0 . 2 0 μ mのライン・アンド・スペースパターンが得られた。

フロントページの続き